

Silicon Diode

BAX81

90V / 350mA / 500mW

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

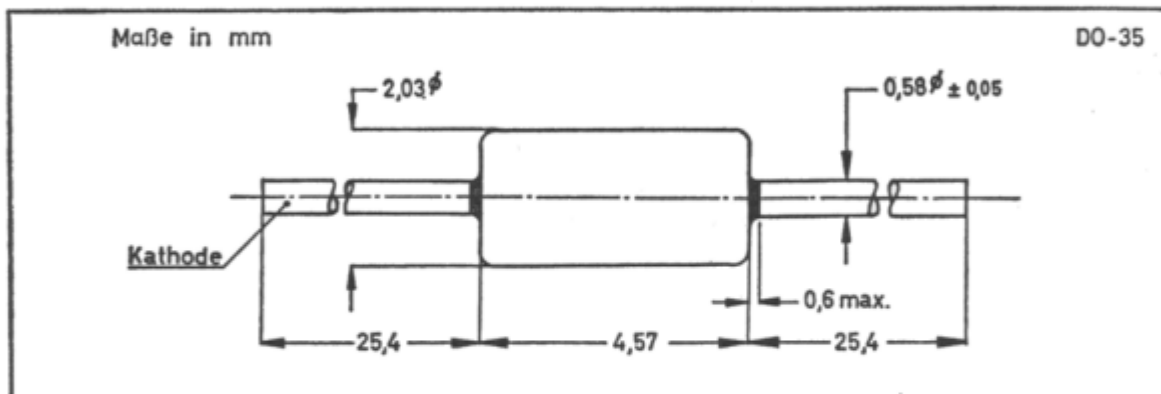
BAX81**Planar-Silizium-Diode im DO-35-Gehäuse für allgemeine Anwendungen****Niedere Schaltzeiten bei hohen Durchlaßströmen****Miniaturbauweise aus nur 4 Einzelteilen****Widerstandsfähig gegen extreme mechanische Beanspruchungen****Mechanische Daten**

Mechanischer Schock 3000 g über 0,2 ms

3 Ebenen

Beschleunigen 20000 g über 1 min/Ebene

6 Ebenen

**Absolute Grenzwerte**

Sperrspannung	90 V
Spitzensperrspannung	90 V
Durchlaßstrom	350 mA
Spitzenstrom bei 1 s Pulsbreite	500 mA
Stoßstrom bei 1 μ s Pulsbreite	4 A
Sperrschichttemperatur	175 °C
Lagerungstemperatur	-65 °C bis +200 °C
Verlustleistung	500 mW
Wärmewiderstand	0,30 °C/mW

Statische Kennwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$ (wenn nicht anders angegeben)

Parameter	Prüfbedingungen	min	typ	max	Einh.
U_{BR}	$I_R = 5\ \mu\text{A}$	90			V
U_F	$I_F = 100\ \mu\text{A}$	0,40	0,46	0,53	V
	$I_F = 1\ \text{mA}$	0,50	0,57	0,65	V
	$I_F = 10\ \text{mA}$	0,60	0,70	0,77	V
	$I_F = 100\ \text{mA}$	0,75	0,85	1,00	V
	$I_F = 200\ \text{mA}$	0,82	1,00	1,15	V
	$I_F = 300\ \text{mA}$	0,88	1,10	1,25	V
I_R	$U_R = 50\ \text{V}$		25	100	nA
I_R	$U_R = 50\ \text{V}$ $T_U = 100\text{ °C}$		2,5	10	μA
I_R	$U_R = 50\ \text{V}$, $T_U = 150\text{ °C}$		35	150	μA
C	$U_R = 0\ \text{V}$		2,5	3,5	pF
t_{rr}	$I_F = 10\ \text{mA}$ $I_R = 10\ \text{mA}$ bis auf $I_R = 1\ \text{mA}$		3,5	5	ns
t_{rr}	$I_F = 200\ \text{mA}$, $I_R = 200\ \text{mA}$ bis auf $I_R = 20\ \text{mA}$		4,5	6	ns

